Catálogo de productos

# Amplificadores de potencia de estado sólido

Los amplificadores de potencia de estado sólido usan dispositivos semiconductores RF de potencia para generar potencia de transmisión sin etapas de tubo. Se usan en transmisores de comunicación, canales radar, plataformas de prueba RF y subsistemas microondas.



Productos: 21

Revisión: 14 · Fecha de revisión: 2026-11-12




## LCPAM-2000-6000-100-485

### Módulo amplificador de potencia RF GaN de banda ancha, 2–6 GHz, 100 W

El LCPAM-2000-6000-100-485 es un módulo amplificador RF de alta potencia y banda ancha con tecnología GaN para 2–6 GHz. Ofrece 100 W de salida saturada típica y 50 dB de ganancia típica. Funciona con 24–32 VDC e incorpora interfaz RS-485, supervisión de estado y desconexión de protección. Puede evaluarse como etapa de potencia en sistemas RF de 50 Ω.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

**Potencia RF de salida saturada:** Símbolo: Pout; Típico: 100; Unidad: W

**Ganancia de potencia:** Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidad: dB

**Tensión de operación:** Símbolo: VDC; Mínimo: 24; Típico: 28; Máximo: 32; Unidad: VDC

Salvo indicación contraria: +28,0 VDC, 25 °C, sistema de 50 Ω

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAM-100-18000-5

### Amplificador de potencia GaN RF de 100–18000 MHz, mínimo 5 W

El amplificador GaN cubre 100–18000 MHz con salida saturada mínima de 5 W y típica de 7 W. La ganancia es mínima 37 dB y típica 38 dB, con planitud típica ±0.5 dB.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 100; Máximo: 18000; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Mínimo: 5; Típico: 7; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 37; Típico: 38; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAM-10700-12700-100

### Amplificador de potencia GaN RF de 10700–12700 MHz, típico 100 W

El amplificador GaN cubre 10700–12700 MHz con salida saturada típica de 100 W y ganancia típica de 50 dB. La planitud típica es ±1 dB, con armónicos típicos −50 dBc a 100 W de salida.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12700; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω. Confirme con LCRF la corriente de funcionamiento y la actuación de la protección contra sobrecorriente antes de dimensionar la fuente de alimentación.

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAM-10700-12700-50

### Amplificador de potencia GaN RF de 10700–12700 MHz, típico 50 W

El amplificador GaN entrega salida saturada típica de 50 W en 10700–12700 MHz y ganancia típica de 47 dB. La corriente dinámica típica es 10 A a 50 W, con corriente de reposo típica de 1.6 A.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12700; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Típico: 50; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Típico: 47; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAM-10700-12750-100

### Amplificador GaN RF de 10700–12750 MHz, típico 100 W, adaptador WR75

El amplificador GaN cubre 10700–12750 MHz con salida saturada típica de 100 W y ganancia mínima de 50 dB. La salida típica en compresión de 1 dB es 40 W; la corriente típica es 21 A a 100 W.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12750; Unidad: MHz

**Potencia de salida en compresión de 1 dB:** Símbolo: P-1dB; Típico: 40; Unidad: W

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 50; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAM-2000-6000-20

### Amplificador GaN RF de 2000–6000 MHz, salida saturada típica 25 W

La ficha de este modelo especifica salida saturada típica de 25 W en 2000–6000 MHz y ganancia típica de 44 dB. La corriente típica de 2.5 A y la eficiencia añadida de potencia de 30% se especifican ambas a 20 W de salida.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Típico: 25; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Típico: 44; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



## LCPAM-20-520-200A

### Módulo amplificador de potencia RF LDMOS de 20–520 MHz, 200 W saturados

El módulo con etapa final LDMOS cubre 20–520 MHz con 200 W de potencia saturada típica. La salida en compresión de 1 dB se especifica aparte en 50 W típicos, con ganancia de pequeña señal típica de 53 dB.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 20; Máximo: 520; Unidad: MHz

**Potencia RF de salida saturada:** Símbolo: Psat; Típico: 200; Unidad: W

**Potencia de salida en compresión de 1 dB:** Símbolo: P1dB; Típico: 50; Unidad: W

**Ganancia de pequeña señal:** Símbolo: G; Típico: 53; Unidad: dB

25 °C; 50 Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



## LCPAM-20-520-350

### Amplificador LDMOS RF de 20–520 MHz, salida saturada típica 350 W

El amplificador LDMOS cubre 20–520 MHz con salida saturada típica de 350 W y salida típica de 150 W en compresión de 1 dB. La ganancia típica es 56 dB, con corriente típica 29 A a 350 W y alimentación típica 48 VDC.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 20; Máximo: 520; Unidad: MHz

**Potencia de salida en compresión de 1 dB:** Símbolo: P-1dB; Típico: 150; Unidad: W

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Típico: 350; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Típico: 56; Unidad: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



## LCPAM-3000-8000-100-485

### Amplificador de potencia GaN RF de 3000–8000 MHz, típico 100 W, RS-485

El amplificador GaN cubre 3000–8000 MHz con salida saturada mínima de 80 W y típica de 100 W. La ganancia es mínima 49 dB y típica 50 dB; la corriente típica es 18 A a 100 W de salida.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 3000; Máximo: 8000; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Mínimo: 80; Típico: 100; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 49; Típico: 50; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±2; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



## LCPAM-30-1000-10

### Amplificador de potencia GaN RF de 30–1000 MHz, típico 10 W

El amplificador GaN cubre 30–1000 MHz con salida saturada mínima de 9 W y típica de 10 W. La ganancia típica es 40 dB con planitud ±1 dB; la corriente típica es 0.6 A a 10 W de salida.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 1000; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Mínimo: 9; Típico: 10; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Típico: 40; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



## LCPAM-30-1500-1

### Amplificador de potencia GaN RF de 30–1500 MHz, mínimo 1 W

El módulo especifica salida saturada mínima de 1 W y ganancia mínima de 30 dB en 30–1500 MHz. La corriente típica es 0.15 A a 1 W, con planitud típica de ganancia ±1 dB.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 1500; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Mínimo: 1; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 30; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



## LCPAM-30-2000-1

### Amplificador de potencia GaN RF de 30–2000 MHz, mínimo 1 W

Este modelo cubre 30–2000 MHz según la tabla eléctrica, con salida saturada mínima de 1 W y ganancia mínima de 30 dB. Los armónicos típicos son −12 dBc a 1 W y las señales espurias típicas −60 dBc en saturación.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 2000; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Mínimo: 1; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 30; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



## LCPAM-5000-6000-100

### Módulo amplificador de potencia RF GaN de 5–6 GHz y ≥100 W

LCPAM-5000-6000-100 especifica una salida saturada mínima de 100 W y una ganancia mínima de 50 dB en PSAT entre 5 y 6 GHz, a 28 VDC, 25 °C y 50 Ω.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

**Potencia RF de salida saturada:** Símbolo: PSAT; Mínimo: 100; Unidad: W; PSAT

**Ganancia de potencia (PSAT):** Símbolo: Gp; Mínimo: 50; Unidad: dB; PSAT

**Planitud de ganancia de potencia (PSAT):** Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB; PSAT

28 VDC; 25 °C; 50 Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



## LCPAM-5000-8500-25

### Amplificador de potencia GaN RF de 5000–8500 MHz, típico 25 W

El amplificador GaN cubre 5000–8500 MHz con salida saturada mínima de 20 W y típica de 25 W. La ganancia es mínima 43 dB y típica 44 dB; los armónicos típicos son −40 dBc a 20 W.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 5000; Máximo: 8500; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



## LCPAM-500-2500-100A

### Amplificador de potencia GaN RF de 500–2500 MHz, típico 100 W, variante A

La variante A GaN cubre 500–2500 MHz con salida saturada típica de 100 W y ganancia típica de 50 dB. La corriente típica es 12 A a 100 W, mientras la medición de armónicos mantiene su condición de salida a 70 W.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 500; Máximo: 2500; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±2; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω La tabla eléctrica indica 26 VDC mínimo, 28 VDC típico y 30 VDC máximo, mientras que la fila A1 VDD indica 28–32 VDC. Se omite la afirmación sobre el rango de A1. Confirmar el rango permitido y el cableado de A1 antes de alimentar; 32 VDC no es aquí un máximo operativo aceptado.

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAM-6000-18000-50

### Amplificador de potencia RF de estado sólido de 6–18 GHz, típico 50 W

El amplificador de estado sólido cubre 6–18 GHz con salida saturada mínima de 45 W y típica de 50 W a entrada 0 dBm. La ganancia típica es 47 dB; la planitud es típica ±1.5 dB y máxima ±2.5 dB bajo la misma condición de entrada.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 6; Máximo: 18; Unidad: GHz

**Potencia RF de salida saturada @ Pin = 0 dBm:** Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 50; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ Pin = 0 dBm:** Símbolo: Gp; Típico: 47; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ Pin = 0 dBm:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±1.5; Máximo: ±2.5; Unidad: dB

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAM-6000-8500-20

### Amplificador de potencia GaN RF de 6000–8500 MHz, mínimo 20 W

La ficha de este modelo especifica salida saturada mínima de 20 W y típica de 25 W en 6000–8500 MHz. La corriente típica de 2.5 A y eficiencia añadida de potencia de 30% corresponden a 20 W; la corriente de reposo típica es 1.8 A.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 6000; Máximo: 8500; Unidad: MHz

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAM-6000-8500-25

### Amplificador de potencia GaN RF de 6000–8500 MHz, típico 25 W

Este modelo especifica salida saturada típica de 25 W y mínima de 20 W en 6000–8500 MHz. La ganancia es típica 44 dB y mínima 43 dB, con planitud típica ±0.5 dB.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 6000; Máximo: 8500; Unidad: MHz

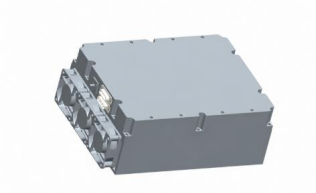
**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidad: dB

**Planitud de ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAM-8000-12000-100

### Amplificador de potencia GaN RF de 8000–12000 MHz, típico 100 W

El amplificador GaN cubre 8000–12000 MHz con salida saturada típica de 100 W y ganancia mínima de 53 dB. La salida típica en compresión de 1 dB es 20 W, con planitud típica ±1.5 dB.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

**Potencia de salida en compresión de 1 dB:** Símbolo: P-1dB; Típico: 20; Unidad: W

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 53; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAS-8000-12000-200

### Sistema amplificador GaN RF de 8000–12000 MHz, típico 200 W

El sistema GaN cubre 8000–12000 MHz con salida saturada típica de 200 W y salida típica de 40 W en compresión de 1 dB. La ganancia es mínima 53 dB con planitud típica ±1.5 dB.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

**Potencia de salida en compresión de 1 dB:** Símbolo: P-1dB; Típico: 40; Unidad: W

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Típico: 200; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 53; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto  Ficha técnica del producto



## LCPAS-8000-12000-400

### Sistema amplificador GaN RF de 8000–12000 MHz, típico 400 W

El sistema GaN especifica salida saturada típica de 400 W en 8000–12000 MHz y salida típica de 120 W en compresión de 1 dB. La ganancia es mínima 56 dB con planitud típica ±1.5 dB.

**Frecuencia de operación:** Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

**Potencia de salida en compresión de 1 dB:** Símbolo: P-1dB; Típico: 120; Unidad: W

**Potencia de salida RF @ PSAT:** Símbolo: PSAT; Típico: 400; Unidad: W

**Ganancia de potencia @ PSAT:** Símbolo: Gp; Mínimo: 56; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto  Ficha técnica del producto

**Aviso del documento**

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.